# パルス通電加熱法により作製した Nb<sub>3</sub>AI 超伝導線材のピン止め特性

原田直幸(電気電子工学科) 浜島高太郎(電気電子工学科) 中川和彦(日立電線㈱) 森合英純(日立電線㈱) 渡辺和雄(東北大学金属材料研究所)

# Pinning Properties in Nb<sub>3</sub>Al Superconducting Wires by Pulsed Ohmic-Heating

Naoyuki HARADA (Department of Electrical and Electronic Engineering) Takatarou HAMAJIMA (Department of Electrical and Electronic Engineering) Kazuhiko NAKAGAWA (Hitachi Cable, Ltd.) Hidezumi MORIAI (Hitachi Cable, Ltd.) Kazuo WATANABE (Tohoku University)

Two kinds of superconducting Nb<sub>3</sub>Al wire have been ohmically-heated at controlled maximum temperatures ranging from 1600 to 2050 in vacuum, in order to investigate the properties of pinning force densities at high magnetic fields. Nb<sub>3</sub>Al tape, which is 3 mm wide and 0.3 mm thick, with monocore in Nb sheath has been fabricated from Nb powders and Al powders. Jelly-rolled Nb<sub>3</sub>Al wire with a Nb matrix is 1.34 mm diameter and 50 mm long. The maximum temperature at the sample-surface was measured by a photodiode. Critical currents were measured up to 23 T by a four probe method. In the tape samples, pinning force densities were changed by the number of ohmic-heating cycles. To make the inside of the superconducting core react more uniformly, ohmic-heating with 5 cycles at 1950 is needed. In the tape samples heated at the approximate melting point of Nb<sub>3</sub>Al, the pinning force densities decrease by the increase of the number of ohmic-heating cycles. On the other hand, the Jelly-rolled samples heated at maximum temperatures less than the melting point of Nb<sub>3</sub>Al have layer structures consisting of Nb-rich regions and Al5 phase regions in longitudinal cross-sections. In the sample heated up to the melting point of Nb<sub>3</sub>Al, these layers are not observed. This sample shows a remarkable peak in the pinning force density at high magnetic fields, over 20 T.

Key Words: Nb<sub>3</sub>Al, Flux pinning, Superconductor, Critical current, Ohmic-heating

### 1. はじめに

臨界温度が 19K、4.2K における上部臨界磁場が 30T である Nb<sub>3</sub>A1 は、歪に対して臨界電流密度の 低下が少ないことから、20T を越える高磁場中で 使用する次世代の超伝導線材として開発が進めら れている。A15 型の結晶構造を持つ Nb<sub>3</sub>A1 は、臨 界磁場や臨界温度などの超伝導特性が、組成のず れに対して敏感に変化する。臨界温度が高い Nb<sub>3</sub>A1 を得るためには、化学量論組成の Nb<sub>3</sub>A1 を 生成する必要がある。このため、Nb<sub>3</sub>A1 が安定な 約 2000 の高温から急冷する方法などが必要と されている。近年、電流を直接線材に流して加熱 する通電加熱法を用いた急熱急冷・変態法<sup>1)</sup>によ リ、臨界電流密度を高くすることができる方法が 開発された。一方、著者は2000 に達する線材の 加熱時の温度をコントロールすることができるパ ルス通電加熱装置を用いて、臨界温度が18Kを越 えるNb<sub>3</sub>AIを得た。<sup>2)</sup>また、出発材料が異なるテ ープ線材を用いてピン止め特性とミクロ組織を比 較し、有効なピン止め点について検討を行ってき た。<sup>3)</sup>結晶粒界が主要なピンニングセンターである A15 型金属間化合物超伝導体の臨界電流密度は、 高磁場において磁場の増加と共に大きく減少する。 今後、高磁場における特性改善を行ない、20T 級



Fig.1 Optical micrograph of longitudinal crosssection of Nb<sub>3</sub>Al tape.

の高磁場中で使用する高性能の線材を得ることが 必要である。

本報告では、Nb層の厚さがそれぞれ異なるテー プ線材とジェリーロール線材の2種類の線材を用 いてパルス通電加熱時の最高到達温度を変化させ、 反応状態を比較し、ピン止め特性を検討した結果 についてまとめた。

#### 2. 実験

#### 2.1 試料

試料として、テープ線材とジェリーロール線材 を用いた。粉末法で作製したテープ線材の出発材 料は、平均粒径が約 20 µ m の Nb 粉末と 10 µ m の Al 粉末である。これらを化学組成比が 3:1 とな るように混合し、 外径 8mm、 内径 5mm の Nb 管に 詰めて加工を行い、最終の断面形状を 0.3mm× 3mm とした。このテープ線材は、Fig.1 に縦断面 写真を示ように Nb シースの間に超伝導コアがあ る。一方、ジェリーロール線材は、外径 1.34mm、 フィラメント径 120 µm、フィラメント数 54 本の 多芯線である。Fig.2 は 2.4 節で述べる陽極酸化を 行なった線材の横断面写真である。ここで Nb<sub>3</sub>Al の生成後に超伝導フィラメントとして振舞う領域 はオレンジ色に着色されている。また、2000 越 える加熱を行なうため、線材のマトリックスは Nb を用いている。

#### 2.2 **熱処理方法**

パルス通電加熱は、2 種類の線材共それぞれ長 さ 50mm の試料を銅製の電極に機械的に取りつけ て、真空中で行った。更に、テープ線材ではコア 内部の未反応の Nb を減少させるため、同一の試 料に対してパルス通電加熱を最高 7 回まで繰り返 して行った。パルス通電加熱を繰り返す場合は、



0.5 mm

Fig.2 Optical micrograph of cross-section in Jelly-rolled Nb<sub>3</sub>Al wire after ohmic-heating.



Fig.3 Pulsed ohmic-heating system.



Fig.4 Example of temperature change at sample surface.

試料を室温程度まで冷却した後、次の加熱を行なった。また、全ての試料に対して、最後にアルゴン雰囲気中において 800 、10時間の A15 相の規則化のための熱処理を行った。<sup>2)</sup>なお、テープ線材では、粉末を充填するときに含まれているガスにより通電加熱時に試料が破断することを防ぐため、通電加熱前にアルゴン雰囲気中において 1100 、10時間の予備熱処理を行った。

本研究で用いたパルス通電加熱装置の構成を Fig.3 に示す。この装置は、試料の温度をコントロ ールする温度制御部と温度検出部から構成される。 電源の周波数は 60Hz である。試料に直接電流を流 すことで、ジュール発熱によって試料を加熱する。 フォトダイオードの出力電圧から試料表面の温度 を換算し、設定した温度に到達すると電流を遮断 するものである。加熱の初期段階では抵抗が小さ いため、過大な電流が試料に流れ、試料の温度を 急激に上昇させることができる。電流を遮断した 後、加熱された試料は電極を介して冷却される。 本研究では特別に冷却する方法は行なっていない。 試料表面における輝度温度は、光高温計を用いて 校正した。試料表面の温度変化の例を Fig.4 に示 す。縦軸はフォトダイオードの出力電圧と Nb の 放射率を考慮して求めた値である。本報告中の試 料名には、試料表面の最高到達温度を用いて表し ている。

#### 2.3 臨界電流密度の測定

試料の臨界電流は、東北大学金属材料研究所強 磁場超伝導材料研究センターのハイブリッドマグ ネット HM-2 を用いて、4.2Kの液体ヘリウム中で 印加磁場 23T から磁場を減少させて、四端子法に より測定した。テープ線材では、磁場はテープの 幅広面に平行に印加した。臨界電流は、試料に 1 μ V/cm の電界が発生した電流値とした。この電流 値をテープ線材ではコアに対して、ジェリーロー ル線材ではフィラメントの領域に対して、それぞ れ単位面積あたりの値を臨界電流密度 Jc とした。 ピン力密度 Fp は、Jc と印加磁場 B との積から求 めた。

#### 2.4 陽極酸化による断面観察

テープ線材におけるコアとジェリーロール線材 のフィラメント内における反応後の状態は、それ ぞれの試料の縦断面を陽極酸化して<sup>4)</sup>、光学顕微 鏡を用いて観察した。陽極酸化の条件としては、 ジェリーロール線材では 3%の蓚酸水溶液中で 23Vの直流電圧を印加して、電流を数分間通電し た。これにより、Nbマトリックスは濃い緑色に、 フィラメント内の 相を含めた A15 相はオレンジ







Fig.5 Optical micrographs of longitudinal crosssection in ohmically-heated samples at (a)1940  $\times 1$ , (b) 1950  $\times 5$ , and (c) 2050  $\times 1$ . 色に着色された。また、Nb に Al が拡散した相は、 薄い緑色に着色された。テープ線材においてもほ ぼ同様の着色を行なった。これらの色は、試料断 面各部の導電率の違いによって形成される酸化膜 の厚さによって異なり、印加電圧や通電時間を変 えることにより変化させることができる。

# 3. 実験結果と検討

#### 3.1 テープ線材

パルス通電加熱後のテープ線材の縦断面を陽極 酸化して、中間化合物の 相(Nb<sub>2</sub>Al)を含む A15 相 領域と未反応の Nb 層の分布を比較した。出発材 料に用いた Nb 粉末の平均粒径が 20µm であった ことから、圧延後に引き伸ばされた Nb は厚さが 約 2~10µm 程度の層であった。このように Nb 層が厚いため、Fig.5(a)に示すように、Nb<sub>3</sub>Alの融 点(約 1950)以下の最高到達温度で1回の通電加 熱を行なった場合、Nb シースと同じ色に着色され た未反応の Nb 層が観察された。また、未反応の Nb 層の周囲に Nb シースよりも薄い緑色の領域が あり、この領域は、Nb層に Al が拡散した領域で あると考えられる。通電加熱を繰り返すことによ り、この領域が減少していくことが観察された。 最高到達温度を1950 として、パルス通電加熱を 5回繰り返した場合、Fig.5(b)に示すようにほとん ど未反応領域が観察されない状態になった。一方、 最高到達温度を高くすると Nb 層が減少するが、 Fig.5(c)に示すように不均一な分布が得られた。 Nb<sub>3</sub>Al の融点を大きく越えた場合、層状の構造が 残っていないことから、このような分布はコアが 部分的に溶融して冷却時に形成されたものと推定 される。

次に、テープ線材におけるピン力密度 Fp の磁場 依存性を Fig.6 にまとめた。パルス通電加熱を 1 回のみとして到達温度を変えた場合を Fig.6(a)に、 1940-1950 と 2000 においてそれぞれパルス通 電加熱を繰り返した結果を Fig.6(b)、(c)にそれぞ れ示す。Fig.6(a)において到達温度が 1940 のとき、 ピン力密度が最大値を示し、到達温度が高くなる につれ Fp は全ての磁場で減少した。Nb<sub>3</sub>AI の融点 を越える温度まで加熱した場合、未反応の領域は 減少して、A15 相の断面積は増加するが、ピンニ ングセンターとして作用する結晶粒が成長して、 有効にピン止めされる量子化磁束の割合が減少し、 ピン止め力密度 Fp が低下したものと考えられる。 到達温度を Nb<sub>3</sub>AI の融点程度として通電加熱を



Fig.6 Magnetic field dependence of pinning force density in tape samples.



Fig.7 Pinning force density at 5T versus number of ohmic-heating cycles.

繰り返していくと、未反応領域は減少するが、結 晶粒が成長するため Fig.6(b)に示されるように Fp は減少すると考えられる。これに対して、到達温 度を 2000 とした場合、加熱を繰り返すと同じ磁 場依存性を示しながら Fp が増加することがわか った。このことはピンニングセンターの大きさは 変化せずに、濃度が変化しているものと考えられ、 融点を越えて加熱するため生成した Nb<sub>3</sub>Al の結晶 粒が加熱時に溶融していることが原因と推測され る。特に、パルス通電の回数に対して低磁場側 5T におけるピン力密度の変化を Fig.7 に示す。Nb<sub>3</sub>Al の融点付近まで加熱した場合と融点以上で繰り返 した場合にピンニングセンターの生成メカニズム が異なることが原因と考えられる。

#### 3.2 ジェリーロール線材

ジェリーロール線材では通電加熱回数は全て 1 回のみとした。まず、断面観察の結果を Fig.8 に 示す。Fig.8(a)に示すように最高到達温度が 1610 では、Nbマトリックスと同じ着色の未反応 Nb 層 が観察された。更に到達温度を高くすると Fig.8(b) に示すように、Nb に Al が拡散した Nb 層が残っ ていることがわかった。一方、Nb<sub>3</sub>Al の融点近傍 の 1940 まで到達温度を上げると Fig.8(c)に示す ように一様にオレンジ色に着色し、層状の構造は 観察されなかった。そこで、陽極酸化の断面写真 から 相を含めた A15 相領域と Nb 層との体積率 Vf の変化を到達温度 Tm に対してまとめた結果を Fig.9 に示す。到達温度が高くなるにつれ、Nb 層 の体積率は減少し、約 1900 以上で急激に減少し ている。これらの結果は、Nb と Al の層厚が 3.1 節に述べたテープ線材に比べて薄く、均一である ため、反応がNb<sub>3</sub>Alテープに比べて一様に進んだ ためと考えられる。

次に、ジェリーロール線材のピン力密度 Fp の磁 場依存性を Fig.10 に示す。Fig.10 に示した試料名 に含まれる 4 桁の数字は最高到達温度を表してい







Fig.8 Optical micrographs of longitudinal crosssection in ohmically-heated samples at (a)1610 , (b)1890 , and (c)1940 .



Fig.9 Tm dependencies of volume-fraction at each composition.

る。Fig.10 から最高到達温度が 1610 から 1890 までの試料では、Fp の大きさとその磁場依存性は ほぼ等しいことがわかる。この結果は断面観察で 層状の構造が残っていることに対応しており、 Nb<sub>3</sub>Al の結晶粒の成長が Nb 層に制限されたため、 到達温度を変化させても、ほぼ同じピン力密度が 得られたものと考えられる。これに対して、層状 の構造が残っていない 1940 の試料では低磁場 側の Fp が減少していることから、Nb<sub>3</sub>Al が成長し た結果であると考えられる。また、高磁場では低 磁場の Fp の減少とは逆にピークが著しく増加す る結果が得られた。

# 4. まとめ

直接線材に電流を流して加熱するパルス通電加 熱法によりテープ線材とジェリーロール線材の最 高到達温度と反応状態およびピン止め特性につい て、比較、検討を行った。いずれの線材において も到達温度が Nb<sub>3</sub>Al の融点より低い場合と、高い 場合において、反応状態やピン止め特性が大きく 異なる結果が得られた。テープ線材では、Nb<sub>3</sub>Al



Fig.10 Magnetic field dependence of pinning force density in Jelly-rolled samples.

の融点以下の温度で、通電加熱を繰り返して行 うことで、未反応の Nb 層が減少し、高磁場にお けるピン力密度が増加していくことがわかった。 一方、ジェリーロール法線材では、Nb<sub>3</sub>Al 融点よ りも低い温度では Nb 層が残り、ピン力密度が到 達温度を変化させてもほぼ同じ値となった。また 1900 以上で反応が一様に進んだ状態となり、同 時に Fp の高磁場におけるピークが顕著に現れた。

今後、急冷を行ない微細な結晶粒を通電加熱 後に生成する急熱急冷・変態法との比較を行ない、 高磁場に有効なピンニングセンターについて検討 を進める予定である。

# 参考文献

- 1) 飯嶋安男 他:日本金属学会誌, <u>61</u> (1997), 829
- 2) 原田直幸 他: 低温工学, 31 (1996), 526
- N. Harada et al. : IEEE Trans. Applied Superconductivity, (1999), 1429
- 4) 金属表面技術協会編:陽極酸化,朝倉書店 (1969)

(平成 11 年度 11 月 30 日受理)